

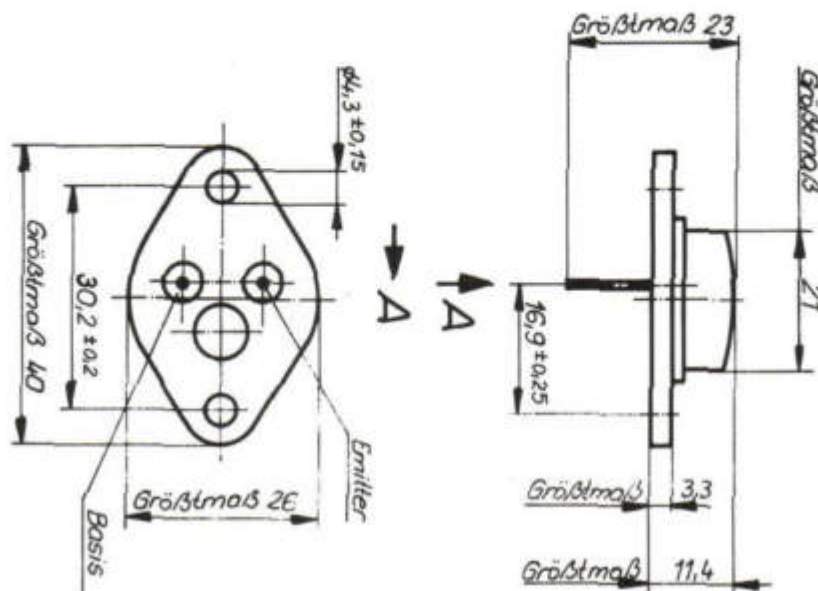
SU 167/169

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Schaltnetzteile und Motorsteuerung.

Maße in mm und Anschlußbelegung

Masse ca. 22 g

Kollektor am
Gehäuse



Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung $I_E = 0$	U_{CBO}	SU 167 800	SU 169 1000 V
Kollektor-Emitter-Spannung $I_B = 0$	U_{CEO}	325	400 V
Kollektorstrom	I_C	10	A
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	15	A
Gesamtverlustleistung $\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	+ 100	W
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	+ 150	$^\circ\text{C}$

Kennwerte, bei $\vartheta_c = 25^\circ\text{C} - 5\text{K}$

		min	typ	max
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{CE} = 800\text{V } 1000\text{V}$ (SU 167) (SU 169)	I_{CEX}			1,0 mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 8\text{A}, I_B = 2,5\text{A}$	U_{CEsat}			3,3 V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 8\text{A}, I_B = 2,5\text{A}$	U_{BEsat}			2,2 V
Kollektor-Basis-Stromverhältnis $U_{CE} = 10\text{V}, I_C = 2,5\text{A}$	h_{21E}	15		
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 100\text{mA}$	$U_{(BR)CEO}$	325) ¹	400) ²	V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung $I_E = 10\text{mA}$	$U_{(BR)EBO}$	8,0		V
Abfallzeit des Kollektorstromes $I_C = 8\text{A}, I_B = -I_B = 2,5\text{A}$	t_f			1,0 μs

)¹ SU 167

)² SU 169

Bestellbezeichnung: Transistor SU 167
Transistor SU 169

Änderungen vorbehalten!

Information 0682



**veb gleichrichterwerk
stahnsdorf
im veb kombinat mikroelektronik**

DDR 1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg
Telex 015220 Telefon 680

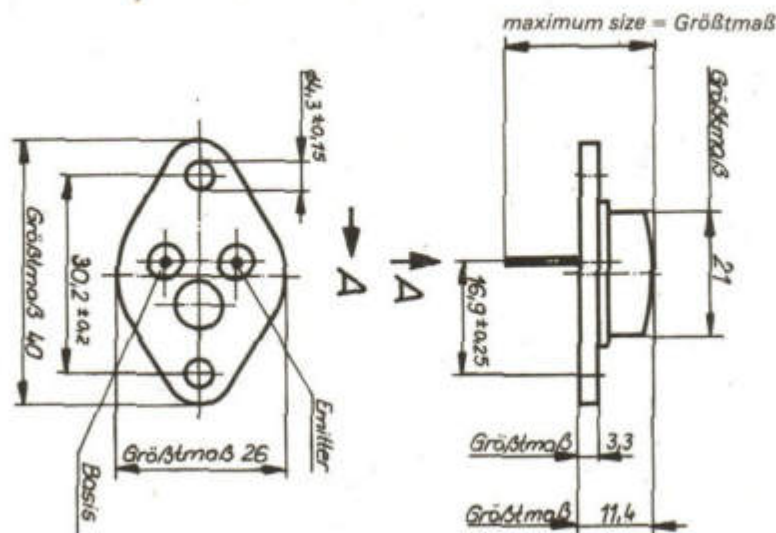
**elektronik
export-import**

Volkseigener Außenhandelsbetrieb
der Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie
Telefon: 2180 · Telex: 114721

SU 167/169 / BUY 69 B / BUY 69 A

n-p-n Si-power switching transistor for switched mode power supplies and motor control

Dimensions in mm and terminals
weight c. 22 g
Collector at case



Maximum ratings ($\vartheta_a = -25 \dots +125^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Collector-base-voltage $I_E = 0$	U_{CBO}	SU 167 800	SU 169 1000	V
Collector-emitter voltage $I_B = 0$	U_{CEO}	325	400	V
Collector current	I_C	10		A
Peak collector current	I_{CM}	15		A
Total power dissipation $\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	100		W
Junction temperature	ϑ_j	+150		$^\circ\text{C}$

Characteristics ($\vartheta_c = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$)

		min.	typ	max.
Collector-emitter cut-off current $U_{CE} = 800\text{ V}, 1000\text{ V}$ (SU 167) (SU 169)	I_{CEX}			1,0 mA
Collector-emitter saturation voltage $I_C = 8\text{ A}, I_B = 2,5\text{ A}$	U_{CEsat}			3,3 V
Base-emitter saturation voltage $I_C = 8\text{ A}, I_B = 2,5\text{ A}$	U_{BEsat}			2,2 V
Static value of the common-emitter forward current transfer ratio $U_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 2,5\text{ A}$	h_{21E}	15		
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100\text{ mA}$	$U_{(BR)CEO}$	325 ¹⁾ 400 ²⁾		V
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\text{ mA}$	$U_{(BR)EBO}$	8		V
Fall time $I_C = 8\text{ A}, I_B = -I_B = 2,5\text{ A}$	t_f			1,0 μs

Denotation for ordering: Transistor SU 167¹⁾
Transistor SU 169²⁾

Alteration reserved!

Ag 05/033/83

RFT

**veb gleichrichterwerk stahnsdorf
im veb kombinat mikroelektronik**

DDR - 1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg
Telefon 6 80 - Telex 015 220

**elektronik
export-import**

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie, Telefon: 2180